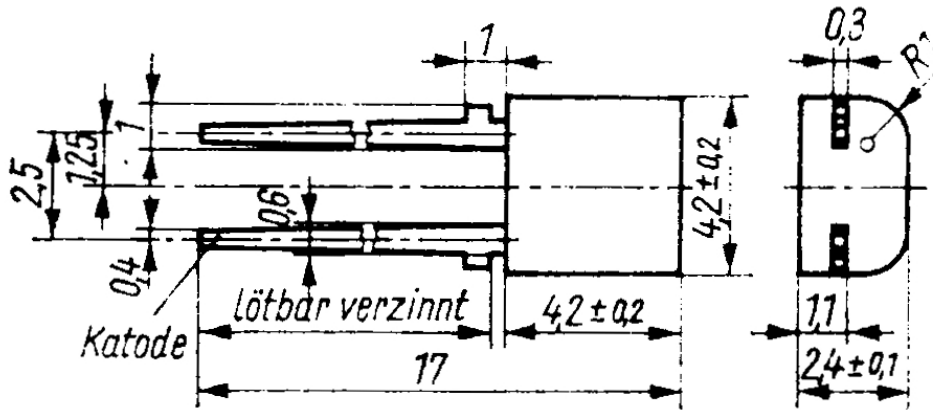


SAY 12 · SAY 16 ... SAY 18 · SAY 20 · SAY 73

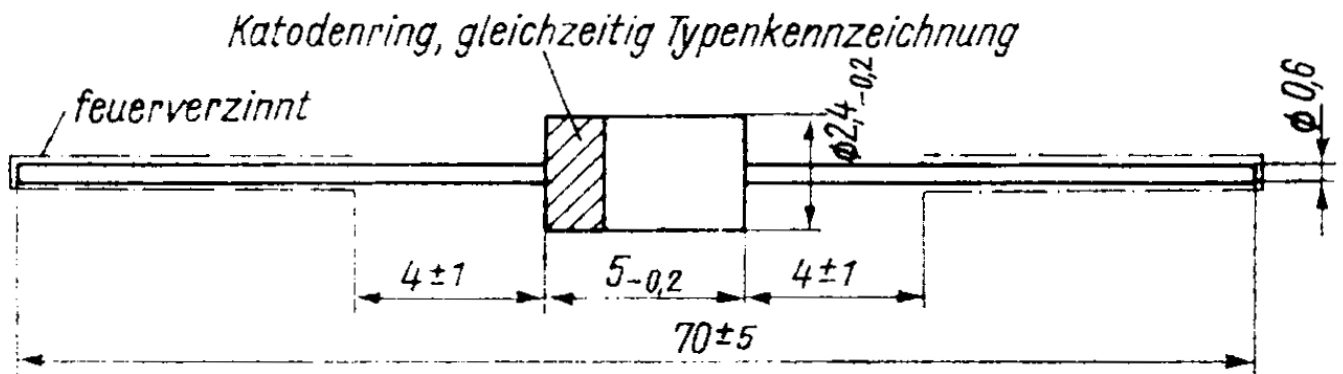


Silizium-Epitaxie-Planardioden in Kunststoffausführung. Sie eignen sich infolge ihrer geringen Sperr-erholungszeit (ns-Bereich) besonders für den Einsatz als schneller Schalter. Lieferbar in Bauform L 2/13 oder Bauform B.

Bauform L 2/13



Bauform B



SAY 73 nur Bauform L 2/13

Grenzwerte (Maximalwerte) bei $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}$

		SAY 12	SAY 16	SAY 17	SAY 18	SAY 20	SAY 73*)
Durchlaßstrom	I_F/mA	300	300	175	115	75	300
Spitzen- durchlaßstrom	I_{FRM}/mA	600	600	350	225	150	600
Sperrspannung	U_R/V	50	30	50	25	15	50
Spitzensperr- spannung	U_{RRM}/V	75	35	60	35	20	75
Richtstrom	I_O/mA	200	200	115	75	50	200
Stoßstrom $t_p \leq 1 \mu\text{s};$ Pause $\geq 2 \text{ min}$)	I_{FSM}/A	2	2	2	2	2	2
Gesamtverlust- leistung	P_{tot}/mW	430	430	300	300	300	430
Sperrschicht- temperatur	$\vartheta_j/^\circ\text{C}$	175	175	150	150	150	175
Wärmewiderstand	$R_{\text{th}} \text{ K/mW}$	0,3	0,3	0,35	0,35	0,35	0,3
Lagerungs- temperatur	$\vartheta_{\text{stg.}} \text{ }^\circ\text{C}$			min. max.	-50 50		

*) speziell für Rechentechnik, hohe Stabilität der Durchlaßspannung

SAY 12

SAY 16

SAY 17

SAY 18

SAY 20

SAY 73

Statische Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ **Durchlaßspannung**

bei $I_F = 10\text{ mA}$	U_F/V	—	—	—	—	≤ 1	—
$I_F = 30\text{ mA}$		—	—	—	≤ 1	—	—
$I_F = 100\text{ mA}$		—	—	≤ 1	—	—	—
$I_F = 200\text{ mA}$		≤ 1	≤ 1	—	—	—	≤ 1

Sperrstrom

bei $U_R = 15\text{ V}$	$I_R/\mu\text{A}$	—	—	—	—	$\leq 0,05$	—
$U_R = 20\text{ V}$		—	—	—	—	≤ 5	—
$U_R = 25\text{ V}$		—	—	—	$\leq 0,07$	—	—
$U_R = 30\text{ V}$		—	$\leq 0,1$	—	—	—	—
$U_R = 35\text{ V}$		—	≤ 5	—	≤ 5	—	—
$U_R = 50\text{ V}$		$\leq 0,1$	—	$\leq 0,1$	—	—	$\leq 0,1$
$U_R = 60\text{ V}$		—	—	≤ 5	—	—	—

Dynamische Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ **Gesamtkapazität**

bei $U_R = 0\text{ V}$	C_{tot}/pF	≤ 4	≤ 4	≤ 3	≤ 4	≤ 4	≤ 4
$f = 1\text{ MHz}$							
und $U_{\text{HF}} = 50\text{ mV}$							

Sperrerrholungszeit	t_{rr}/ns	≤ 4	≤ 4	≤ 2	≤ 2	≤ 4	≤ 4
----------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

beim Schalten von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $U_{\text{R\&M}} = 6\text{ V}$, gemessen bei $I_R = 1\text{ mA}$